

N沟道双栅极的MOS- FET的

BF1212 ; BF1212R ; BF1212WR

特点

- 具有较高的正向传输短沟道晶体管输入电容比
- 低噪声增益控制放大器
- 出色的低频噪声性能
- 部分内部自偏置电路，以确保良好的AGC和好时的交叉调制性能DC稳定。

应用

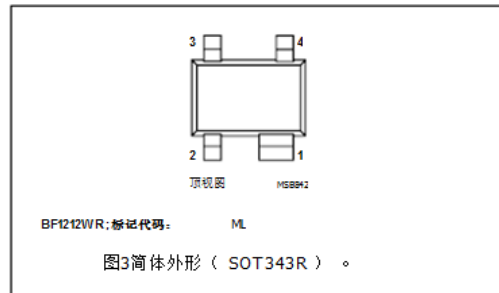
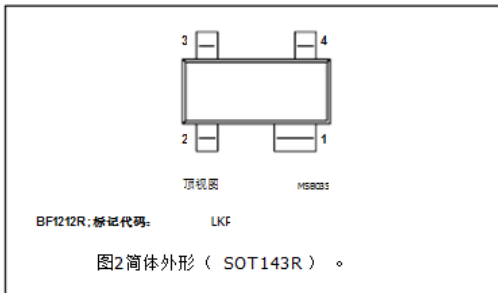
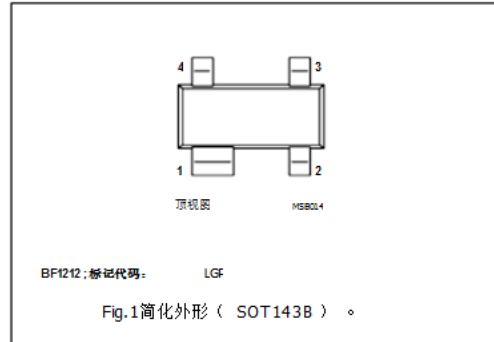
- 增益控制的低噪声VHF和UHF放大器5 V数字和模拟电视调谐器的应用程序。

描述

增强型与N沟道场效应晶体管源和基体相互关联的。集成的二极管门和源极之间防止过高的输入电压浪涌。该BF1212，BF1212R和BF1212WR被封装在所述SOT143B，SOT143R和SOT343R塑料封装分别。

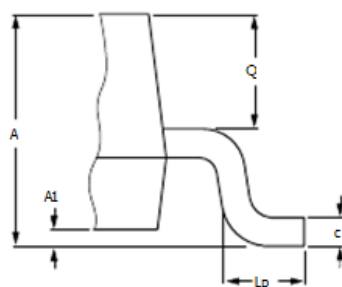
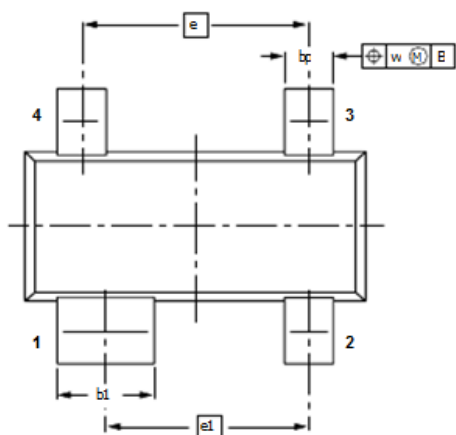
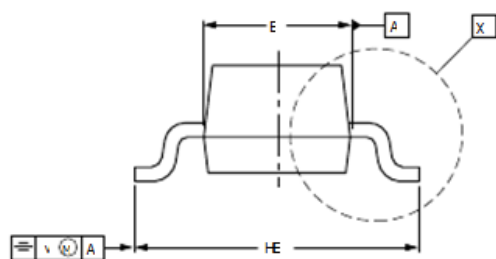
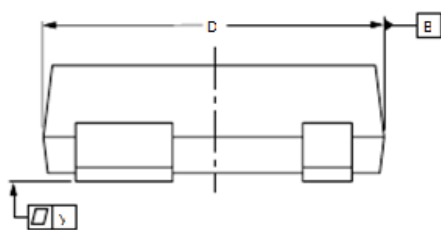
钉扎

针	描述
1	来源
2	漏
3	门2
4	门1

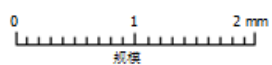


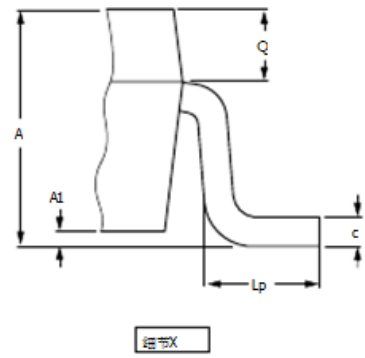
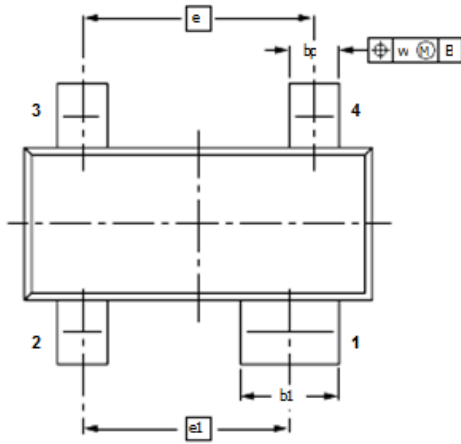
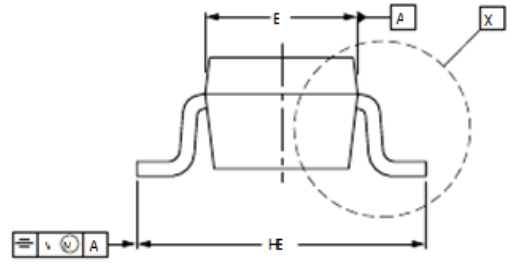
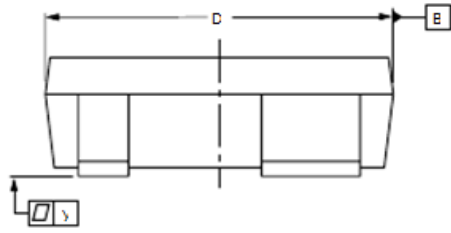
快速参考数据

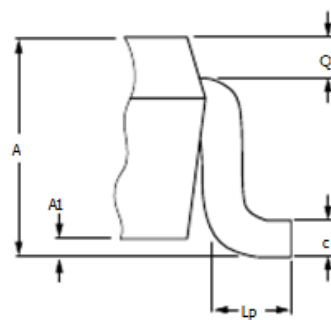
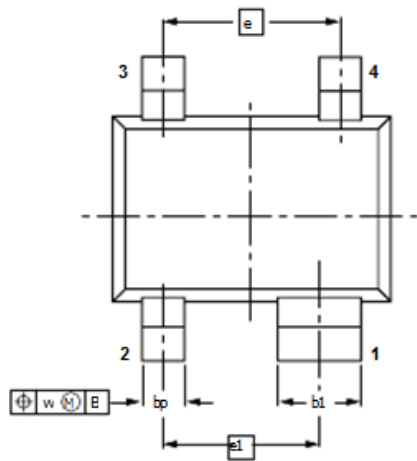
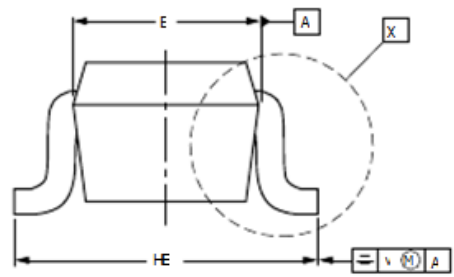
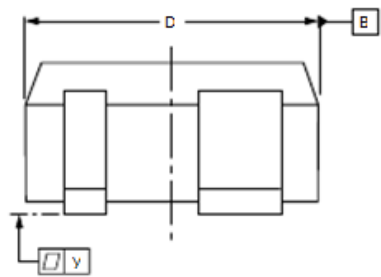
符号	参数	条件	分钟	典型值	马克斯	单位
V_{DS}	漏源电压		-	-	6	V
I_C	漏电流		-	-	30	mA
$P_{\text{合计}}$	总功耗		-	-	180	mW
$\tau_{\text{转移}}$	正向转移导纳		28	33	43	mS
C_{ig1-ss}	在1号门的输入电容		-	1.7	2.2	pF
C_{RSS}	反向传输电容	$F = 1 \text{ MHz}$ 的	-	15	30	fF
F	噪音科幻gure	$F = 800 \text{ MHz}$ 的	-	1.1	1.8	dB
X_{MCD}	交叉调制	输入电平对于 $k = 1 \%$ 40分贝AGC	100	104	-	dB μ V的
T_j	结温		-	-	150	$^{\circ}\text{X}$



剖切X







细节X